新闻稿

美光宣布量产面向移动应用、业内容量最高的单片式存储器

- *业内首款单片 12Gb LPDDR4x DRAM 解决方案，大幅降低功耗并提升性能*
- *基于 10 纳米工艺的 LPDDR4x 量产*

爱达荷州博伊西，2018 年 11 月 7 日——美光科技股份有限公司（纳斯达克代码：MU）今天宣布，已经开始量产业内容量最高的首款单片 12Gb 低功耗双倍数据速率 4x（LPDDR4x）DRAM，适用于移动设备和应用。该最新一代美光 LPDDR4 存储器在功耗上做出了重大改进，同时保持了业内最高的 LPDDR4 时钟频率，从而为下一代手机和平板电脑提供高级性能。此外，美光的 12Gb LPDDR4x 实现了双倍的存储容量，与上一代产品相比，在不增加体积的情况下提供了业内容量最高的单片 LPDDR4。

人工智能（AI）、增强现实（AR）和 4K 视频等计算型和数据密集型移动应用的使用量呈指数增长。相应地，移动用户需要最大化电池续航时间和性能，以及更高的容量。集成了多个高分辨率摄像头并更多地使用人工智能进行图像优化的下一代移动设备也需要更高的 DRAM 容量来支持这些功能。

随着行业开始部署 5G 移动技术，手机中的存储子系统将必须支持大幅提升的数据传输速率以及相关的实时数据处理。基于 5G 技术的新应用还将借助存储器子系统更高的功能，以便实现全新的沉浸式用户体验。

作为业内容量最高的单片移动存储器，美光的 LPDDR4x DRAM 提供了行业领先的带宽和能效，并能为手机带来更高的 DRAM 容量。

美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理 Raj Talluri 表示：“美光在低功耗 DRAM 技术方面是公认的业内先驱，我们再次通过推出业内首款容量最高的单片 12Gb 移动 DRAM 而实现了新的里程碑。随着用户因为数据密集型应用而需要高性能、大容量和更长的电池续航时间，该最新一代的 LPDDR4 让手机制造商们能够通过超薄移动设备提供丰富的用户体验。”

LPDDR4x DRAM 将采用 10 纳米工艺，实现提升效率和降低电池功耗。在与上一代类似的 4,266Mb/s 数据传输速率下，美光的 LPDDR4x 移动 DRAM 能实现能耗降低至最多 10%。

美光 12Gb LPDDR4 存储器解决方案即日起上市。欲了解更多信息看，请访问 www.micron.com。

关于美光科技股份有限公司

美光科技是创新内存和存储解决方案领域的全球领导者。通过旗下全球性品牌 Micron®（美光）、Crucial®（英睿达）和 Ballistix®（铂胜），美光丰富的高性能内存和存储技术组合——包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 存储，正通过改变世界使用信息的方式来丰富生活。凭借近 40 年的技术领军地位，美光的存储解决方案帮助颠覆性趋势在诸如云、数据中心、网络、移动和汽车等重要市场中的实现，这些趋势包括人工智能、机器学习和自动驾驶。美光科技的普通股在纳斯达克上市交易，股票代码是 MU。如需了解美光科技股份有限公司的更多信息，请访问 micron.com。

© 2018 Micron Technology, Inc. 版权所有。信息、产品和/或规格如有更改，恕不另行通知。对于排版设计或摄影方面的遗漏或错误，Crucial 和美光科技有限公司均不负责。美光、美光徽标、Crucial 及 Crucial 徽标均为美光科技有限公司的商标或注册商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

请关注我们，加入美光科技社交平台，一起交流关于存储和创新的话题：

- ***博客：*** http://blog.sina.com.cn/microntechnology
- ***微博：***

微信：

媒体联系人：

伟达（中国）公共关系顾问有限公司
李笑雨 女士
电话：010 - 6512 8811
E-mail: xiaoyu.li@hkstrategies.com